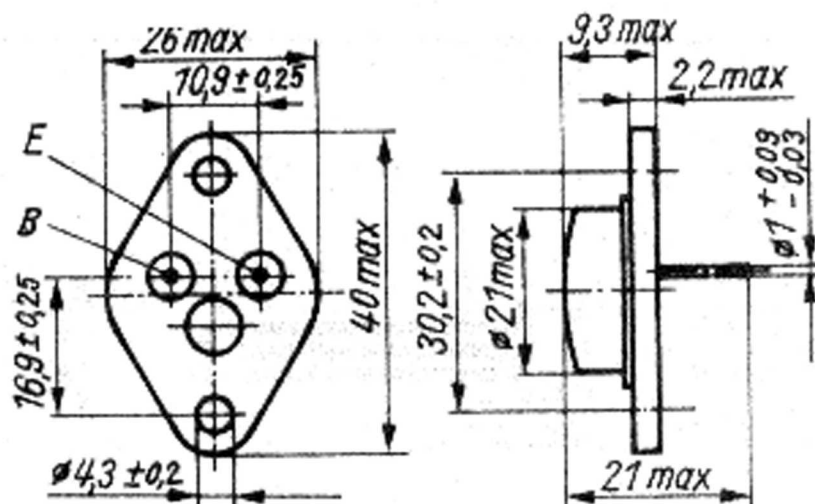


SU 167/SU 169

Silizium-npn-Leistungsschalttransistoren für Schaltnetzteile und Motorsteuerung

Bauform 5



Kollektor am Gehäuse

Wärmewiderstand $R_{thjc} \leq 1,25 \text{ K/W}$

Grenzwerte (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

	SU 167	SU 169
U_{CBO} ($I_E = 0$)	800	1 000 V
U_{CEO} ($I_B = 0$)	325	400 V
I_C		10 A
I_{CM}		15 A
P_{tot} ($\vartheta_c \leq 25^\circ\text{C}$)		100 W
ϑ_j		-25 ... +150 °C
ϑ_a		-25 ... +125 °C

Elektrische Kennwerte bei $\vartheta_c = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$ min typ max

I_{CEX}	($U_{CE} = 800 \text{ V}, 1\,000 \text{ V}, U_{BE} = -2 \text{ V}$)	\leq	1,0 mA
U_{CEsat}	($I_C = 8,0 \text{ A}, I_B = 2,5 \text{ A}$)	\leq	3,3 V
U_{BEsat}	($I_C = 8,0 \text{ A}, I_B = 2,5 \text{ A}$)	\leq	2,2 V
h_{21E}	($U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 2,5 \text{ A}$)	\geq	15
$U_{(BR)CEO}$	($I_C = 100 \text{ mA}$)	\geq	325
$U_{(BR)EBO}$	($I_C = 10 \text{ mA}$)	\geq	400 V
t_f	($I_C = 8,0 \text{ A}, I_B = -I_B = 2,5 \text{ A}$)	\leq	8,0 V
		\leq	1,0 μs